

材料系共同利用研究報告会

超高压電子顕微鏡による学術研究は、我国がこれまで世界的にリードし、今後も最先端を走り続ける分野と考えられています。この度、大阪大学超高压電子顕微鏡センターを利用して得られた研究成果の報告会を開催いたしますので、ふるってご参加ください。

日時：平成24年12月20日（木） 13:00-19:00

場所：大阪大学産学連携本部A棟1階セミナー室

（旧先端科学イノベーションセンター・インキュベーション棟A棟1階セミナー室）

プログラム

13:00-13:10 開会の挨拶 保田 英洋（大阪大学）

座長：保田 英洋（大阪大学）

13:10-13:50 MeV Electron Irradiation In-Situ HVEM Studies on the Impact of Doping on {113}-Defect Formation in Silicon
Jan Vanhellemont（Ghent University）

13:50-14:20 面内に複屈折を有する(110)ポーラスシリコンの3次元構造解析
藤井 稔（神戸大学）

14:20-14:50 超高压電子顕微鏡による金属における自己格子間原子のダイナミクスの抽出
荒河 一渡（島根大学）

14:50-15:00 休憩

座長：永瀬 丈嗣（大阪大学）

15:00-15:30 いくつかの形状記憶合金に現れる散漫な衛星反射
福田 隆（大阪大学）

15:30-16:00 電子照射によるアモルファス酸化物の結晶化
～その場観察による構造変化の追跡～
仲村 龍介（大阪府立大学）

16:00-16:10 休憩

座長：小林 慶太（大阪大学）

16:10-16:40 III-V族化合物半導体GaSb, InSbの電子照射による構造変化
新田 紀子（高知工科大学）

16:40-17:10 MeV電子照射による純金属ナノ粒子の構造不規則化と相転移
保田 英洋（大阪大学）

17:30-19:00 懇親会 於 さわらび（参加費：3,000円）

連絡先：永瀬丈嗣

567-0047 茨木市美穂ヶ丘7-1 大阪大学 超高压電子顕微鏡センター

E-mail: t-nagase@uhvem.osaka-u.ac.jp

Tel: 06-6879-7941, Fax: 06-6879-7942